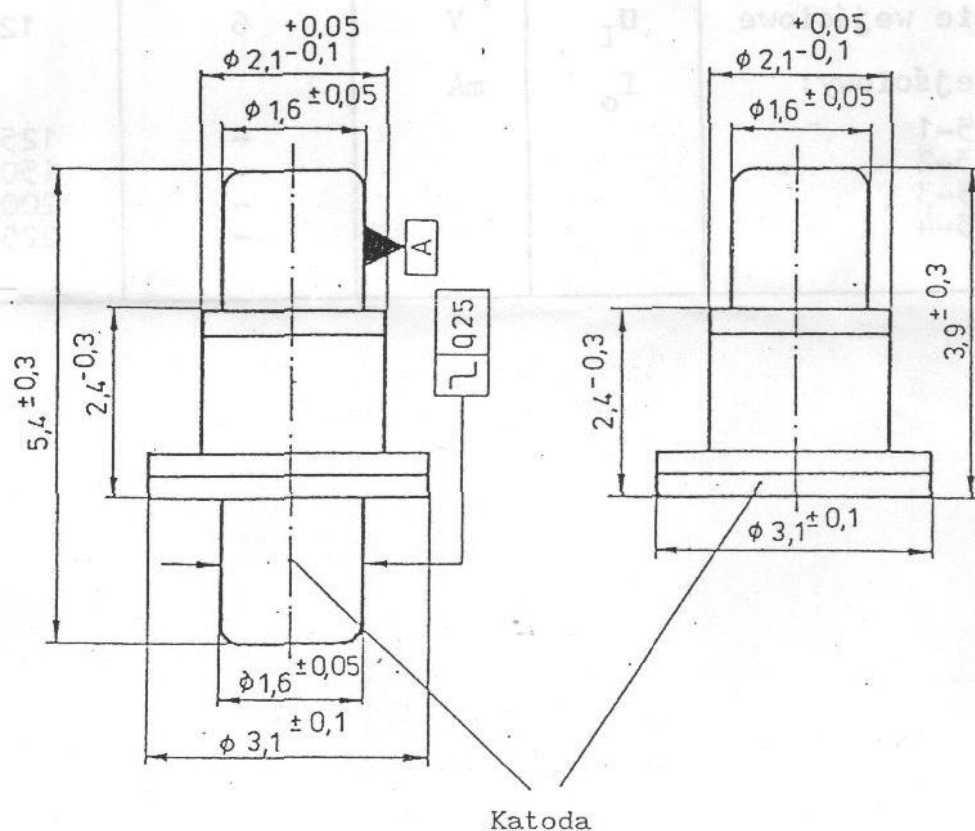


CXYP 43

Dioda Gunna

Informacja: prof. dr hab. Inż. Jerzy Klamka
tel. (0-22) 47 21 61
fax (0-22) 47 06 31

Dioda CXYP 43 jest arsenkowo-galową diodą Gunna małej mocy, umieszczona w ceramiczno-metalowej obudowie. Wytwarzana jest w 4 wersjach: CXYP 43-1, CXYP 43-2, CXYP 43-3, CXYP 43-4. Dioda przeznaczona jest do generacji mocy mikrofalowej w pasmie X.



Obudowa diody CXYP 43

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napięcie wejściowe	U_I	12 V
Temperatura pracy	t_{amb}	$40 \pm 55 ^\circ C$
Temperatura przechowywania	t_{c+a}	$-55 \pm 100 ^\circ C$

ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru	Symbol	Jedn.	Wartość	
			min	max
Częstotliwość generacji	f_o	GHz	8	12
Moc wyjściowa:	P_o	mW		
CXYP 43-1			5	-
CXYP 43-2			10	-
CXYP 43-3			15	-
CXYP 43-4			20	-
Napięcie wejściowe	U_I	V	6	12
Prąd wejściowy:	I_o	mA		
CXYP 43-1			-	125
CXYP 43-2			-	150
CXYP 43-3			-	200
CXYP 43-4			-	225



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al.Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel. (0-22) 47 21 61, 43 49 83 • Fax (0-22) 47 06 31